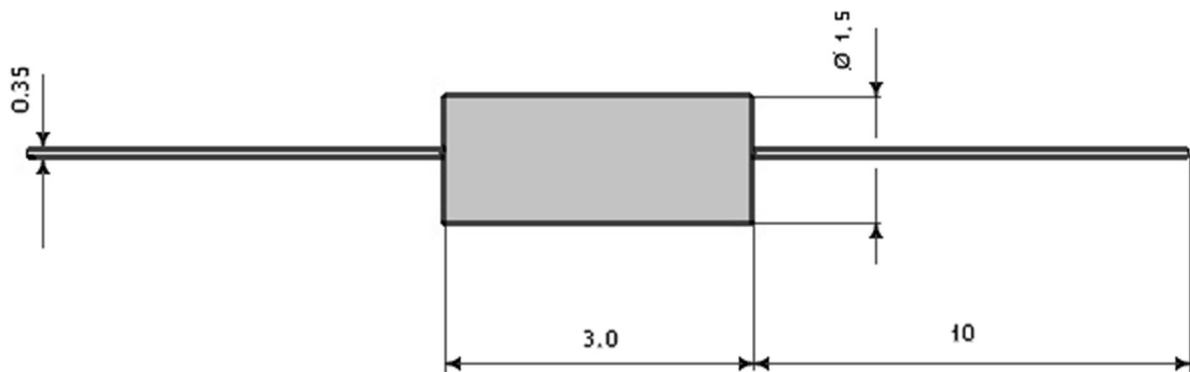


# ДИОД **3A112A**

**Сверхвысокочастотный диод 3A112A смесительный, арсенид-галлиевый, планарно-эпитаксиальный с барьером Шоттки.**



Диоды 3A112A арсенид-галлиевые, планарно-эпитаксиальные, с барьером Шоттки, смесительные.

Предназначены для применения в преобразователях частоты сантиметрового диапазона длин волн в составе гибридных интегральных микросхем и микросборок, обеспечивающих герметизацию и защиту приборов от воздействия влаги, соляного тумана, плесневых грибов, инея и росы, пониженного и повышенного давления.

Выпускаются в стеклянном корпусе с жесткими выводами типа КД-1-3.

Диоды выпускаются подобранными в пары и четверки и обозначаются 3A112AP, 3A112AG, AA112AP, AA112AG.

Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на индивидуальной таре. Отрицательный вывод диода - со стороны кристалла.

Масса диода не более 0,035 г.

Пример записи условного обозначения при заказе и в конструкторской документации:

диод СВЧ 3A112A, ТТЗ.336.023 ТУ,

диод СВЧ 3A112AP, 3A112AG, ТТЗ.336.023 ТУ/Д2,

диод СВЧ AA112A, ТТЗ.360.066 ТУ.

Основные технические параметры СВЧ диода 3A112A:

- Потери преобразования: не более 7,5 дБ;
- Выпрямленный ток: 1...2,5 мА;
- Выходное шумовое отношение: не более 1,6;
- Нормированный коэффициент шума: не более 6,5 дБ;
- Коэффициент стоячей волны по напряжению: не более 1,8;
- Выходное сопротивление: 300...550 Ом;
- Непрерывная рассеиваемая мощность: 20 мВт
- Импульсная падающая мощность: 150 мВт;
- Значение допустимого статического потенциала: не более 200 В;
- Температура окружающей среды: -60...+100°C;